

已经授权专利

1. 肖长江、靳常青、王晓慧，高密度纳米陶瓷的制备方法，专利号：ZL200410083676.8，
专利授权时间：2006.4.12
2. K·麦登、余勇、靳常青，交流磁化率测量用压力胞及其施压装置和交流磁化率测量系
统，专利号：ZL200710176823.X，专利授权时间：2009.12.2
3. 刘青青、杨华、杨留响、余勇、禹日成、李凤英、靳常青，一种提高顶角氧掺杂高温超
导转变温度的方法，专利号：ZL200810057513.0，专利授权时间：2009.12.30
4. 朱金龙、李凤英、靳常青，低温高压下样品的介电常数和介电损耗测量装置及方法，专
利号：ZL200810117329.0，专利授权时间：2010.6.23
5. 余勇、杨留响、靳常青，高压实验用振动式交流磁信号探测系统，专利号：
ZL200810055937.3。专利授权时间：2010.8.11
6. 靳常青、刘青青、赵景庚，一种立方钙钛矿结构 BaRuO_3 晶体及其制备方法，专利号：
ZL200810057519.8，专利授权时间：2010.09.29
7. 龙有文、杨留响、靳常青， $\text{Sr}_{1-x}\text{Ca}_x\text{CrO}_3$ 钙钛矿莫特化合物及其高压高温合成方法，专
利号：ZL200810057515.X，专利授权时间：2010.9.29 无效
8. 赵景庚、杨留响、靳常青，一种“6H”- BaIrO_3 晶体及其制备方法，专利号：
ZL200810057520.0，专利授权时间：2010.9.29
9. 游淑洁、陈良辰、靳常青，一种金刚石对顶压砧充气装置，专利号：ZL201120023620.9，
专利授权时间：2011.8.3
10. 靳常青、望贤成、刘青青、吕玉玺、高伟波、杨留响、李凤英、禹日成，一种铁基高温
超导晶体及其制备方法，专利号：ZL200910077293.2，专利授权时间：2012.3.21
11. 朱金龙、冯少敏、王丽娟、刘青青、李凤英、靳常青，一种多铁材料 $\text{Bi}_2\text{NiTiO}_6$ 的磁性
能和铁电性能的调控方法，专利号：ZL201010164815.5；专利授权时间：2012.9.5
12. 邓正、靳常青、望贤成，一种磁电功能材料及其制备方法，专利号：ZL201010117666.7，
专利授权时间：2012.10.3
13. 吕玉玺、刘青青、靳常青，6H 相钙钛矿 BaCrO_3 晶体及其制备方法，专利号：
ZL201010281020.2，专利授权时间：2013.4.17
14. 吕玉玺、刘青青、靳常青，一种掺杂 Mott 化合物晶体及其制备方法，专利号：

ZL201110127442.9, 专利授权时间: 2013.6.5

15. 于润泽、望贤成、孔盼盼、刘青青、靳常青, 一种超高压新相 Cu₂Sb 合金晶体及其制备方法, 专利号: ZL201210074831.4, 专利授权时间: 2013.10.30
16. 朱洁、刘青青、靳常青, 碲化银晶体及其制备方法, 专利号: ZL 201210150810.6, 专利授权时间: 2014.12.24
17. 陈碧娟、邓正、靳常青, 一种半导体材料 BaF_xZnAs 及其制备方法, 专利号: ZL 201310119534.1, 专利授权时间: 2016.5.3
18. 邓正、靳常青, 一种铁磁半导体材料 Li(Zn, Mn)P 及其制备方法, 专利号: ZL 201310091221X, 专利授权时间: 2016.4.21
19. 靳常青、赵侃、邓正, 一种稀磁半导体材料 (Ca, Na) (Zn, Mn)₂As₂ 及其制备方法, 专利号: ZL201410302565.5, 专利授权时间: 2017.07.21
20. 赵侃、邓正、靳常青, 一种稀磁半导体材料及其制备方法, 专利号: ZL201210593000.8, 专利授权时间: 2017.07.21
21. 靳常青、陈碧娟、邓正, 一种稀磁半导体材料 (Sr, Na) (Zn, Mn)₂As₂ 及其制备方法, 专利号: ZL201410201977.X, 专利授权时间: 2018.03.02
22. 靳常青、陈碧娟、邓正, 镉基铁磁半导体材料及其制备方法, 专利号: ZL201610115621.3, 专利授权时间: 2019.03.08
23. 靳常青、陈碧娟、邓正, 氟基铁磁半导体材料及其制备方法, 专利号: ZL201610157611.6, 专利授权时间: 2019.04.05
24. 靳常青、赵国强、林朝镜、李永庆、邓正, 一种安德烈夫反射结及其制备方法和应用, 专利号: ZL201710106167.X, 专利授权时间: 2019.10.25
25. 靳常青、张俊、望贤成, 一种磁性半导体材料及其制备方法, 专利号: ZL2017110635851, 专利授权时间: 2020.01.07
26. 靳常青、于爽、邓正, 具有巨磁阻效应的稀磁半导体材料及其制备方法, 专利号: ZL201711192940.5, 专利授权时间: 2020.06.02
27. 靳常青、赵国强、邓正, 一种铁磁半导体材料的单晶生长方法, 专利号: ZL2017101061684, 专利授权时间: 2020.07.28
28. 靳常青、赵建发、李文敏、曹立朋、望贤成、于润泽, 多阶有序钙钛矿 PbHg₃Ti₄O₁₂ 晶体及其制备方法, 专利号: ZL 201910159365.1, 专利授权时间: 2021.05.25
29. 冯少敏、肖川、靳常青, 一种一氧化碳的聚合方法, 专利号: ZL 202011034869.X, 专利

授权时间：2021.10.19

30. 段磊、靳常青、望贤成，一种铁磁金属材料及其制备方法和应用，专利号：ZL202110785655.4，专利授权时间：2022.03.08
31. 靳常青、何鑫、冯少敏，一种高压实验制样表征一体化组合方法，专利号：ZL202011155247.2，专利授权时间：2022.04.08
32. 靳常青、赵建发、李文敏、张俊，钙钛矿材料及其制备方法和应用，专利号：ZL202110635567.6，专利授权时间：2022.05.24
33. 靳常青、张俊、冯少敏、肖川，具有复合结构的高张力键能释放材料及其制备方法，专利号：ZL202111085305.3，专利授权时间：2024.01.26